

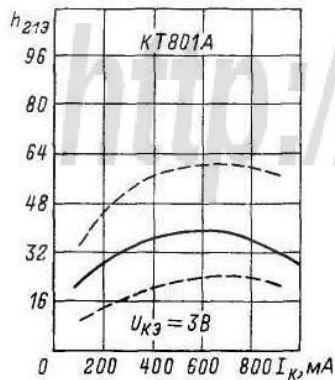
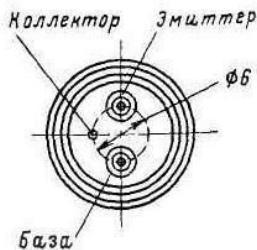
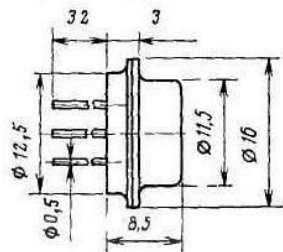
КТ801А, КТ801Б

Электрические параметры

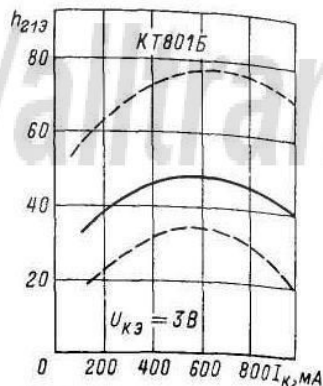
Транзисторы кремниевые диффузионно-сплавные *n-p-n* мощные. Предназначены для работы в схемах кадровой и строчной разверток, вторичных источниках питания.

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 4 г.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

<http://alltransistors.com>

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$, $I_{к} = 0,3 \text{ А}$ не менее	10 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5 \text{ В}$, $I_{к} = 1 \text{ А}$	
КТ801А	13–50
КТ801Б	30–150
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{к} = 1 \text{ А}$, $I_{б} = 0,2 \text{ А}$ не более	2 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 100 \text{ Ом}$ не более	
КТ801А	
при $U_{КЭ} = 80 \text{ В}$, $T_{к} = 233 - 298 \text{ К}$	10 мА
при $U_{КЭ} = 40 \text{ В}$, $T_{к} = 358 \text{ К}$	20 мА
КТ801Б	
при $U_{КЭ} = 60 \text{ В}$, $T_{к} = 233 - 298 \text{ К}$	10 мА
при $U_{КЭ} = 30 \text{ В}$, $T_{к} = 358 \text{ К}$	20 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 2,5 \text{ В}$ не более	2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 100 \text{ Ом}$	
при $T_{к} = 233 - 328 \text{ К}$	
КТ801А	80 В
КТ801Б	60 В
при $T_{к} = 358 \text{ К}$	
КТ801А	40 В
КТ801Б	30 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	2,5 В
Постоянный ток коллектора	2 А
Постоянный ток базы	0,4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T_{к} = 233 - 328 \text{ К}$	5 Вт
при $T_{к} = 358 \text{ К}$	2 Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 233 до 358 К

Примечание. При температуре корпуса от 328 до 358 К напряжение и рассеиваемая мощность снижаются линейно.